

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 7 部門第 2 区分
【発行日】平成 17 年 8 月 11 日 (2005.8.11)

【公開番号】特開 2003-243380 (P2003-243380A)
【公開日】平成 15 年 8 月 29 日 (2003.8.29)
【出願番号】特願 2003-41345 (P2003-41345)
【国際特許分類第 7 版】
H 0 1 L 21/3065
C 2 3 C 16/46
【F I】
H 0 1 L 21/302 1 0 1 D
C 2 3 C 16/46

【手続補正書】
【提出日】平成 17 年 1 月 25 日 (2005.1.25)
【手続補正 1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項 1】

電極ブロックの温度を制御し、半導体ウエハの温度を制御する方式の保持ステージを備えたプラズマ処理装置において、

前記電極ブロックに、内側と外側で独立した温度制御手段を設けると共に、これら温度制御手段の間にほぼ同心円状に形成された熱伝達抑制用のスリットを設けたことを特徴とするプラズマ処理装置。

【請求項 2】

電極ブロックの温度を制御し、半導体ウエハの温度を制御する方式の保持ステージを備えたプラズマ処理装置において、

前記電極ブロックに、内側と外側で独立した温度制御手段を設けると共に、これら温度制御手段の間に熱伝達抑制用のスリットを設け、

前記内側と外側で独立した温度制御手段を、

前記電極ブロックの中で当該電極ブロックの内側と外側で独立して設けられている第 1 と第 2 の流路と、これら第 1 と第 2 の流路に、温度と流量の少なくとも一方が制御された熱媒を独立して供給する第 1 と第 2 の熱媒供給手段で構成したことを特徴とするプラズマ処理装置。